

Модули силовые полупроводниковые

Тип Туре	U _{зкр.и} U _{обр.и} (U _{DRM} U _{RRM})	I _{зкр.и} I _{обр.и} (I _{DRM} I _{RRM})	I _{откр.ср.} макс I _{T(AV)}	I _{откр.уд} I _{уд.пр} (I _{TSM} I _{FSM})	U _{пр.и} (U _{FM})	*U _{из} (U _{MG})	(dU _{закр} /dt) crit (du/dt) crit	U _{от.у.и} (U _{GMT})	I _{от.у.и} (I _{GMT})	R _{г.пер-кор} R _{th(j-c)}	T _{пер} (T _J)	m (W)
	В	мА	А	кА	В	В	В/мкс	В	мА	°С/Вт	°С	кг
МТТ1-40	400-2000	12,0	40	1,3	2,0	2000	50-1000	4,0	150	0,72	125	0,135
МТТ1-63	400-2000	12,0	63	1,5	2,0	2000	50-1000	4,0	150	0,44	125	0,135
МТТ1-80	400-2000	12,0	80	1,9	2	2000	50-1000	4,0	150	0,36	125	0,135
МТТ1-100	400-2000	12,0	100	2,0	1,75	2000	50-1000	4,0	150	0,32	125	0,135
МТОД1-40 МДТО1-40	400-2000	6,0	40 T _C – 70°C	1,3	2,0	2000	20-1000	2,5	250	0,72	110	0,13
МТОД1-63 МДТО1-63	400-2000	6,0	63	1,5	2,0	2000	20-1000	2,5	250	0,44	110	0,13
МТОД1-80 МДТО1-80	400-2000	6,0	80	1,5	2,0	2000	20-1000	2,5	250	0,36	110	0,13
МТОД1-100 МДТО1-100	400-2000	6,0	100	1,6	1,75	2000	20-1000	2,5	250	0,32	110	0,13
МДТ1-40 МТД1-40	400-2000	12,0	40	1,3	2,0	2000	50-1000	4,0	150	0,72	125	0,135
МДТ1-63 МТД1-63	400-2000	12,0	63	1,5	2,0	2000	50-1000	4,0	150	0,44	125	0,135
МДТ1-80 МТД1-80	400-2000	12,0	80	1,9	2,0	2000	50-1000	4,0	150	0,36	125	0,135
МДТ1-100 МТД1-100	400-2000	12,0	100	2,0	1,75	2000	50-1000	4,0	150	0,32	125	0,135
МДД1-40 МДД1-63	400-2000 400-2000	12,0 12,0	40 63	1,5 1,7	1,5 1,5	2000 2000	- -	- -	- -	0,88 0,54	140 140	0,135 0,135
МДД1-80 МДД3-100	400-2000 400-2000	12,0 12,0	80 100	1,9 1,9	1,5 1,5	2000 2000	- -	- -	- -	0,42 0,36	140 140	0,135 0,135
МТОТО1-40 МТОТО1-63	400-2000 400-2000	6,0 6,0	40 63	1,3 1,5	2,0 2,0	2000 2000	20-1000 20-1000	2,5 2,5	250 250	0,72 0,44	110 110	0,135 0,135
МТОТО1-80	400-2000	6,0	80	1,5	2,0	2000	20-1000	2,5	250	0,36	110	0,135
МТОТО1-100	400-2000	6,0	100	1,6	1,75	2000	20-1000	2,5	250	0,32	110	0,135
МТОТО1-100 МДТО1-100	200-1600	15,0	100	2,2	2,5	2000	20-1000	3,0	250	0,3	110	0,5
МТОТО1-125 МДТО1-125	200-1600	15,0	125	2,8	2,2	2000	20-1000	3,0	250	0,28	110	0,5
МТОТО1-160 МДТО1-160	200-1600	15,0	160	3,6	2,0	2000	20-1000	3,0	250	0,25	110	0,5
МДД1-100 МДД1-125	200-1600 200-1600	25,0 25,0	100°C 125	2,8 3,1	1,7 1,7	2000 2000	- -	- -	- -	0,32 0,28	140 140	0,5 0,5
МДД1-160	200-1600	25,0	160	4,4	1,7	2000	-	-	-	0,26	140	0,5
МДТО2-10	200-1600	5,0	10 T _C – 70°C	400	2,0	2000	20-1000	3,0	250	1,5	110	0,13
МТТ3-125 МДТ-125 МТД-125	200-1600	20,0	125	3,0	1,9	2000	20-1000	3,5	200	0,27	125	0,5
МТТ3-160 МДТ-160 МТД-160	200-1600	20,0	160	4,0	1,75	2000	20-1000	3,5	200	0,25	125	0,5

*U_{из} – дано для повторных проверок (действующее значение напряжения)

Гарантийные обязательства

Тип прибора	ТУ	Гарантийный срок, год	Гарантийный срок наработки, ч
Модули силовые полупроводниковые на токи до 100 А	ТУ 16-729.366-92	2	10000
Модули силовые полупроводниковые на токи от 100 до 160 А	ТУ16-91 ИЖТШ.435000.009 ТУ	2	10000

